

# 2SK2633LS

NチャネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ  
超高速スイッチング用

暫定規格

特長  
・低オン抵抗。  
・低 $Q_g$ 化。

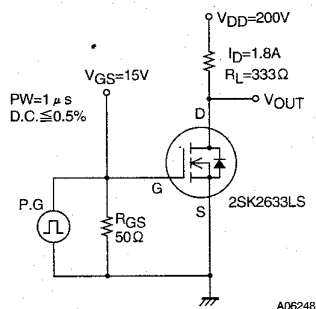
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

|              |           |                 | unit             |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| ドレイン・ソース電圧   | $V_{DSS}$ | 800             | V                |
| ゲート・ソース電圧    | $V_{GSS}$ | $\pm 30$        | V                |
| ドレイン電流 (DC)  | $I_D$     | 3               | A                |
| ドレイン電流 (パルス) | $I_{DP}$  | 9               | A                |
| 許容損失         | $P_D$     | 30              | W                |
| チャネル温度       | $T_{ch}$  | 150             | $^\circ\text{C}$ |
| 保存周囲温度       | $T_{stg}$ | $-55 \sim +150$ | $^\circ\text{C}$ |

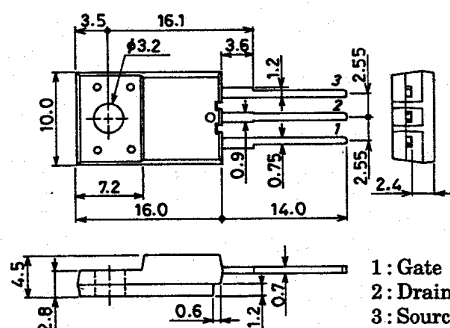
電気的特性 Electrical Characteristics /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

|               |               |                                                                  | min | typ | max       | unit     |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------|
| ゲート・ソース降伏電圧   | $V_{(BR)DSS}$ | $I_D = 1\text{mA}, V_{GS} = 0$                                   | 800 |     |           | V        |
| ドレイン・ソースしや断電流 | $I_{DSS}$     | $V_{DS} = 800\text{V}, V_{GS} = 0$                               |     |     | 1.0       | mA       |
| ゲート・ソースもれ電流   | $I_{GSS}$     | $V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0$                            |     |     | $\pm 100$ | nA       |
| カットオフ電圧       | $V_{GS(off)}$ | $V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1\text{mA}$                          | 3.5 |     | 5.5       | V        |
| 順伝達アドミタンス     | $ Y_{fs} $    | $V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1.8\text{A}$                         | 0.9 | 1.8 |           | S        |
| 飽和抵抗          | $R_{DS(on)}$  | $I_D = 1.8\text{A}, V_{GS} = 15\text{V}$                         |     | 2.8 | 3.6       | $\Omega$ |
| 入力容量          | $C_{iss}$     | $V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$                           |     | 700 |           | pF       |
| 出力容量          | $C_{oss}$     | $V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$                           |     | 180 |           | pF       |
| 帰還容量          | $C_{rss}$     | $V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$                           |     | 100 |           | pF       |
| ゲート入力電荷量      | $Q_g$         | $V_{DS} = 200\text{V}, I_D = 3\text{A}$<br>$V_{GS} = 10\text{V}$ |     | 20  |           | nC       |
| ターンオン遅延時間     | $t_{d(on)}$   | 下図指定回路において                                                       |     | 20  |           | ns       |
| 立上り時間         | $t_r$         | "                                                                |     | 20  |           | ns       |
| ターンオフ遅延時間     | $t_{d(off)}$  | "                                                                |     | 50  |           | ns       |
| 下降時間          | $t_f$         | "                                                                |     | 25  |           | ns       |
| ダイオード順電圧      | $V_{SD}$      | $I_S = 3\text{A}, V_{GS} = 0$                                    |     |     | 1.2       | V        |

スイッチングタイム測定回路図



外形図 2078B  
(unit: mm)



SANYO: TO-220FI(LS)

本製品は開発中です。  
詳細については営業担当者にご連絡ください。